

Doç.Dr. DURMUŞ ALİ ALDEMİR

Kişisel Bilgiler

İş Telefonu: [+90 246 211 4045](tel:+902462114045)

Fax Telefonu: [+90 246 211 4399](tel:+902462114399)

E-posta: durmusaldemir@sdu.edu.tr

Web: <https://avesis.sdu.edu.tr/durmusaldemir>

Eğitim Bilgileri

Doktora, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Türkiye Devam Ediyor
Yüksek Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, --, Türkiye Devam Ediyor
Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik, Türkiye Devam Ediyor

Araştırma Alanları

Fizik, Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 2021 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, 2006 - 2010

Verdiği Dersler

Fizik Laboratuvarı II, Lisans, 2017 - 2018

Fizikte Özel Konular, Lisans, 2017 - 2018

Fizik Laboratuvarı I, Lisans, 2017 - 2018

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. **The response of high barrier Schottky diodes to light illumination**
Lapa H. E., KÖKCE A., ALDEMİR D. A., ÖZDEMİR A. F.
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- II. **Effect of illumination on electrical parameters of Au/(P3DMTFT)/n-GaAs Schottky barrier diodes**
Lapa H. E., KÖKCE A., ALDEMİR D. A., ÖZDEMİR A. F., ALTINDAL Ş.
INDIAN JOURNAL OF PHYSICS, cilt.94, sa.12, ss.1901-1908, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- III. **Photodiode based on Al-doped SnO₂: Fabrication, current-voltage and capacitance-conductance-voltage measurements**
ALDEMİR D. A., Benhaliliba M., Benouis C. E.
OPTİK, cilt.222, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- IV. **The interfacial properties of Au/n-4H-SiC structure with (Zn-doped PVA) interfacial layer**
Lapa H. E., KÖKCE A., ALDEMİR D. A., ÖZDEMİR A. F., ALTINDAL Ş.
PHYSICA SCRIPTA, cilt.95, sa.11, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

- V. **The origin of anomalous peak and negative capacitance on dielectric behavior in the accumulation region in Au/(0.07 Zn-doped polyvinyl alcohol)/n-4H-SiC metal-polymer-semiconductor structures/diodes studied by temperature-dependent impedance measurements**
Al-Dharob M. H. , KÖKCE A., ALDEMİR D. A. , ÖZDEMİR A. F. , Altındal S.
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, cilt.144, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- VI. **Electrical and photoelectric properties of Yb/CIGS thin film Schottky photodiode**
Aldemir D. A. , Kaleli M., Yavru A. C.
SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL, cilt.311, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- VII. **The evaluation of the current-voltage and capacitance-voltage-frequency measurements of Yb/p-Si Schottky diodes with a high zero-bias barrier height**
Lapa H. E. , Guclu C. S. , ALDEMİR D. A. , ÖZDEMİR A. F.
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, cilt.126, sa.6, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- VIII. **Analysis of current-voltage and capacitance-voltage characteristics of Zr/p-Si Schottky diode with high series resistance**
ALDEMİR D. A.
MODERN PHYSICS LETTERS B, cilt.34, sa.10, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- IX. **The Effects of Thermal Neutron Irradiation on Current-Voltage and Capacitance-Voltage Characteristics of Au/n-Si/Ag Schottky Barrier Diodes**
ALDEMİR D. A. , ALDEMİR R., KÖKCE A., Duman S., ÖZDEMİR A. F.
SILICON, cilt.11, sa.6, ss.2647-2657, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- X. **The presence of C/omega-V and G/omega-V peaks profile of Ag/SnO2/n-Si/Au MOS junction for capacitor applications**
BENHALİLİBA M., Benouis C. E. , ALDEMİR D. A.
PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.572, ss.175-183, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- XI. **Structural, morphological and optical properties of Yb2Cu2O5 thin films**
ALDEMİR D. A.
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.30, sa.21, ss.19457-19462, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- XII. **The investigation of current-conduction mechanisms (CCMs) in Au/(0.07Zn-PVA)/n-4H-SiC (MPS) Schottky diodes (SDs) by using (I-V-T) measurements**
Al-Dharob M. H. , Lapa H. E. , KÖKCE A., ÖZDEMİR A. F. , ALDEMİR D. A. , Altındal S.
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, cilt.85, ss.98-105, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- XIII. **Temperature effects on the electrical characteristics of Al/PTh-SiO2/p-Si structure**
ALDEMİR D. A. , KÖKCE A., ÖZDEMİR A. F.
BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE, cilt.40, sa.7, ss.1435-1439, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- XIV. **Effect of Layer Thickness on I-V Characteristics of GaInP Nanofibers Fabricated by Electrospinning on n-Si Substrates**
Bezir N., Evcin A., OKCU H., KAYALI R., KALELİ M., ALDEMİR D. A.
ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.132, sa.3, ss.638-641, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- XV. **Electric and photoelectric properties of n-AgInSe2/p-Si heterojunction diode fabricated by successive layer deposition**
KALELİ M., ALDEMİR D. A. , PARLAK M.
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, cilt.123, sa.9, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- XVI. **The analysis of hydrostatic pressure dependence of the Au/native oxide layer/n-GaAs/Au-Ge Schottky diode parameters**
ÖZDEMİR A. F. , OZSOY T., KANSIZ Y., SANCAK M., KÖKCE A., UÇAR N., ALDEMİR D. A.
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, cilt.60, sa.1, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- XVII. **Temperature dependent ideality factor and barrier height of Ni/n-GaAs/In Schottky diodes**
ALDEMİR D. A. , KÖKCE A., ÖZDEMİR A. F.
MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.98, ss.6-11, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
- XVIII. **Time Dependence of Current-Voltage Characteristics of Pb/p-Si Schottky Diode under Hydrostatic**

Pressure

UÇAR N., Özdemir A. F. , ALDEMİR D. A. , Cankaya G.

ZEITSCHRIFT FÜR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, cilt.66, ss.576-580, 2011
(SCI İndekslerine Giren Dergi)

XIX. Analysis of current-voltage and capacitance-voltage-frequency characteristics in Al/p-Si Schottky diode with the polythiophene-SiO₂ nanocomposite interfacial layer

ALDEMİR D. A. , Esen M., KÖKCE A., KARATAS S., ÖZDEMİR A. F.

THIN SOLID FILMS, cilt.519, sa.18, ss.6004-6009, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

XX. Electrical and optical properties of p-type silicon based on polypyrrole-derivative polymer

ÖZDEMİR A. F. , AYDIN S. G. , ALDEMİR D. A. , Sen Gursoy S.

SYNTHETIC METALS, cilt.161, ss.692-697, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

XXI. Neutron irradiation effects on I-V characteristics of Au/n-GaAs Schottky diodes

AKKURT İ., AKYILDIRIM H., ÖZDEMİR A. F. , ALDEMİR D. A.

RADIATION MEASUREMENTS, cilt.45, sa.10, ss.1381-1383, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

XXII. The effect of hydrostatic pressure on the electrical characterization of Au/n-InP Schottky diodes

UÇAR N., ÖZDEMİR A. F. , ALDEMİR D. A. , ÇAKMAK S., CALIK A., YILDIZ H., Cimilli F.

SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES, cilt.47, sa.5, ss.586-591, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

XXIII. Electrical properties of Al/conducting polymer (P2ClAn)/p-Si/Al contacts

ÖZDEMİR A. F. , ALDEMİR D. A. , KÖKCE A., Altındal S.

SYNTHETIC METALS, cilt.159, sa.14, ss.1427-1432, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

XXIV. The effects of the temperature on I-V and C-V characteristics of Al/P2ClAn(C₂H₅COOH)/p-Si/Al structure

Özdemir A. F. , KOTAN Z., ALDEMİR D. A. , Altındal S.

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, cilt.46, sa.2, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. **Ultrasonik Sprey Piroiliz Yöntemi ile Üretilen Güneş Soğurucu CH₃NH₃PbI₃-xCl_x Perovskit Yapısının Optik, Morfolojik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi**
AKYÜREKLİ S., KALELİ M., KOÇ M., ALDEMİR D. A.
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.253-263, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- II. **Doğal Oksit Arayüzey Tabakalı Zr/p-Si Schottky Diyotlarının Yüksek Frekanslarda Kapasite-Gerilim ve İletkenlik-Gerilim Karakteristiklerinin Analizi**
ALDEMİR D. A. , LAPA H. E. , ÖZDEMİR A. F. , UÇAR N.
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.1024-1030, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- III. **Ultrasonik Sprey Piroiliz ile Üretilen Flor Katkılı Kalay Oksit İnce Filmlerin Yapısal, Morfolojik, Optiksel ve Elektriksel Analizleri**
KALELİ M., ALDEMİR D. A. , BAYRAM A. B. , YAVRU C. A.
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.2107-2115, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- IV. **Mo/n-Si Schottky Diyotların Akım-Voltaj ve Kapasite-Voltaj Karakteristiklerinin Analizi**
GÜÇLÜ Ç. Ş. , ÖZDEMİR A. F. , ALDEMİR D. A.
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.2142-2155, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- V. **n-AgInSe₂/p-Si Heteroeklem Diyodunun Sıcaklığa Bağlı Akım-Gerilim Karakteristikleri**
ALDEMİR D. A. , KALELİ M.
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.18-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
- VI. **Schottky diyot parametrelerini belirlemede kullanılan metotların geniş bir sıcaklık aralığı için kıyaslanması**
ALDEMİR D. A. , KÖKCE A., ÖZDEMİR A. F.

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

- I. **The Reverse Bias Current- Voltage-Temperature (I-V-T) Characteristics of the (Au/Ti)/Al₂O₃/n-GaAs Schottky Barrier Diodes (SBDs) in Temperature Range of 80-380K**
GÜÇLÜ Ç. Ş. , ÖZDEMİR A. F. , ALDEMİR D. A.
6th International conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019), 16 - 18 Ekim 2019, ss.111
- II. **The Illumination Effects on nearly Ideal Yb/p-Si Schottky Diodes with a High Zero-Bias Barrier Height**
LAPA H. E. , KÖKCE A., ALDEMİR D. A. , ÖZDEMİR A. F.
6th International conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019), 16 - 18 Ekim 2019, ss.111
- III. **The Analysis of Capacitance-Voltage and Conductance voltage Characteristics of Zr/p-Si Schottky Diodes with a Native Oxide Interfacial Layer at High Frequencies**
ALDEMİR D. A. , ÖZDEMİR A. F. , UÇAR N.
International Natural Science, Engineering and Materials Technology Conference (NEM 2019), 9 - 10 Eylül 2019, ss.87
- IV. **Uv-Visible study of Yb₂Cu₂O₅ thin film grown by thermal oxidation of Yb/Cu layers**
ALDEMİR D. A. , ÖZDEMİR A. F.
2nd International Congress on Semiconductor materials and Devices, 28 - 30 Ağustos 2018, ss.110
- V. **Annealing Effects on Current-Voltage Characteristics of Yb/p-Si Schottky Diodes**
ALDEMİR D. A.
Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, Bodrum/Muğla, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2018, ss.264
- VI. **Analysis of Current-Voltage and Capacitance-Voltage Characteristics of Mo/n-Si Schottky Diodes**
GÜÇLÜ Ç. Ş. , ÖZDEMİR A. F. , ALDEMİR D. A.
5th International conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2018), 4 - 06 Ekim 2018, ss.130
- VII. **The current-voltage and capacitance-voltage characteristics of Gd/p-Si Schottky diodes, Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Bodrum/TURKEY, September 6-10 2017, Abstract Book p. 348.**
ALDEMİR D. A. , ÖZDEMİR A. F. , KÖKCE A.
Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, 6 - 10 Eylül 2017, ss.348
- VIII. **The current-voltage and capacitance-voltage characteristics of Gd/p-Si Schottky diodes**
ALDEMİR D. A. , ÖZDEMİR A. F. , KÖKCE A.
Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Bodrum/TURKEY, Muğla, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2017, cilt.1, sa.1, ss.348
- IX. **Al/CIGS/Mo SCHOTTKY DİYOTLARININ ELEKTRİKSEL KARAKTERİZASYONU**
ALDEMİR D. A. , Alsaedi S., KALELİ M., Yavru C. A. , KOÇ M., Akyurekli S.
ADIM FİZİK GÜNLERİ VI, Balıkesir, Türkiye, 19 - 21 Temmuz 2017, ss.71
- X. **Al/CIGS/Mo Schottky Diyotlarının Elektriksel Karakterizasyonu, ADIM FİZİK GÜNLERİ VI, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 19 - 21 TEMMUZ 2017, BALIKESİR / TÜRKİYE, Özet Kitapçığı s. 71.**
ALDEMİR D. A. , ALSAEDİ S., KALELİ M., YAVRU C. A. , KOÇ M., AKYÜREKLİ S.
ADIM FİZİK GÜNLERİ VI, Türkiye, 19 - 21 Temmuz 2017
- XI. **Characterization of GaInP Nanofibers Prepared by Electrospinning Process**
ÇİÇEK BEZİR N., EVCİN A., OKÇU H., KAYALI R., KALELİ M., ALDEMİR D. A.
iccesen 2016, 19 - 24 Ekim 2016
- XII. **Investigation of Capacitance-Voltage Characteristics of Au/Conductive Ploymer (P3DMTFT)/n-GaAs**

Schottky Diode

Kansız Y., KÖKCE A., ALDEMİR D. A. , ALTINDAL Ş., ÖZDEMİR A. F.

ADIM FİZİK GÜNLERİ III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2014, cilt.1, sa.1, ss.172

- XIII. **The Effects of Illumination on Capacitance-Voltage Characteristics of Au/Conducting Polymer (P3DMTFT)/n-GaAs Schottky Diodes**
LAPA H. E. , KÖKCE A., ALDEMİR D. A. , ALTINDAL Ş., ÖZDEMİR A. F.
ADIM FİZİK GÜNLERİ III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2014, cilt.1, sa.1, ss.162
- XIV. **Investigation of current-voltage-temperature characteristics in Al/p-SiSchottky diode with the polythiophene SiO₂ nanocomposite interfacial layer**
ALDEMİR D. A. , KÖKCE A., ÖZDEMİR A. F.
International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC-2014), 13 - 15 Ocak 2014, ss.99
- XV. **D. A. Aldemir, A. Kökce, A. F. Özdemir, Investigation of current-voltage-temperature characteristics in Al/p-SiSchottky diode with the polythiophene SiO₂ nanocomposite interfacial layer**
ALDEMİR D. A. , KÖKCE A., ÖZDEMİR A. F.
International Semiconductor Science and Technology Conference, Istanbul, Turkey, January 13-15 2014, ISSTC-2014, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Ocak 2014, ss.98
- XVI. **Analysis of electrical and photovoltaic characteristics of Au/ poly (3-substituted thiophene) (P3DMTFT) / n-GaAs Schottky diode**
LAPA H. E. , KÖKCE A., ALDEMİR D. A. , Sevgili Ö., ÖZDEMİR A. F.
Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul/Türkiye, Abstract Book p. 527., İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2013, cilt.1, sa.1, ss.527
- XVII. **Analysis of current-voltage (I-V) characteristics in Au/ poly (3-substituted thiophene) (P3DMTFT) / n-GaAs Schottky diodes, 05 -08 Eylül 2012, Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi.**
KÖKCE A., LAPA H. E. , ALDEMİR D. A. , ÖZDEMİR A. F.
05 -08 Eylül 2012, Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2012, cilt.1, sa.1, ss.605
- XVIII. **Analysis of current-voltage (I-V) characteristics in Au/ poly (3-substituted thiophene) (P3DMTFT) / n-GaAs Schottky diodes**
KÖKCE A., LAPA H. E. , ALDEMİR D. A. , ÖZDEMİR A. F.
Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 5 - 08 Eylül 2012, ss.605
- XIX. **The comparison of important contact parameters of Ni/n-GaAs/In Schottky diodes obtained by different methods**
ALDEMİR D. A. , KÖKCE A., ÖZDEMİR A. F.
Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2011, cilt.1, sa.1, ss.655
- XX. **The analysis of hydrostatic pressure dependence of Au/n-GaAs/Au-Ge Schottky diode parameters with different methods**
ÖZDEMİR A. F. , UÇAR N., ALDEMİR D. A. , KANSIZ Y., ÖZSOY T., SANCAK M.
Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 6 - 09 Eylül 2011, ss.743
- XXI. **Neutron irradiation effects on I- V characteristics of Au/n-GaAs Schottky diodes**
AKKURT İ., AKYILDIRIM H., ÖZDEMİR A. F. , ALDEMİR D. A.
11th Neutron and Ion Dosimetry Symposium (NEUDOS-11), 12 - 16 Ekim 2009, ss.25
- XXII. **Radiation hazards on electrical properties of Schottky diodes**
AKYILDIRIM H., ALDEMİR D. A. , GÜNOĞLU K., ÖZDEMİR A. F. , AKKURT İ.
Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 24 - 27 Ağustos 2009
- XXIII. **Electrical characterization of p-type Silicon based on conducting polymer**
ÖZDEMİR A. F. , GÜRKAN AYDIN S., ALDEMİR D. A. , ŞEN GÜR SOY S.
Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 24 Ağustos 2009, ss.448
- XXIV. **Analysis of current-voltage characteristic in Al/p-Si Schottky diode with the polythiophene-SiO₂ nanocomposite interfacial layer,**

ALDEMİR D. A. , ESEN M., KÖKCE A., ÖZDEMİR A. F.

Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 24 - 27 Ağustos 2009, ss.437

XXV. **Temperature dependence of electrical parameters of Al/P2ClAn(C2H5COOH)/p-Si/Al structure**

ÖZDEMİR A. F. , KOTAN Z., ALDEMİR D. A. , KÖKCE A., ALTINDAL Ş.

Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi, 28 - 31 Ağustos 2007, ss.529

XXVI. **ÖZDEMİR A.F., ALDEMİR D. A , KÖKCE A., ALTINDAL S., Current-Voltage(I-V) and Capacitance-Voltage-Frequency(C-V-f) Characteristics of Al/P2ClAn(C2H5COOH)/p-Si/Al Schottky diode**

ÖZDEMİR A. F. , ALDEMİR D. A. , KÖKCE A., ALTINDAL Ş.

Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi., Malatya, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2007, cilt.1, sa.1, ss.130

XXVII. **Current-Voltage(I-V) and Capacitance-Voltage-Frequency(C-V-f) Characteristics of Al/P2ClAn(C2H5COOH)/p-Si/Al Schottky diode**

ÖZDEMİR A. F. , ALDEMİR D. A. , KÖKCE A., ALTINDAL Ş.

Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi, 28 - 31 Ağustos 2007, ss.534

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi , Editörler Kurulu Üyesi, 2017 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Solid-State Electronics, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2019

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):152

h-indeksi (WOS):6